



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

966 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）

芯片代码：A089BJ-00

芯片厚度： $240 \pm 20\mu\text{m}$

管芯尺寸： $890 \times 890\mu\text{m}^2$

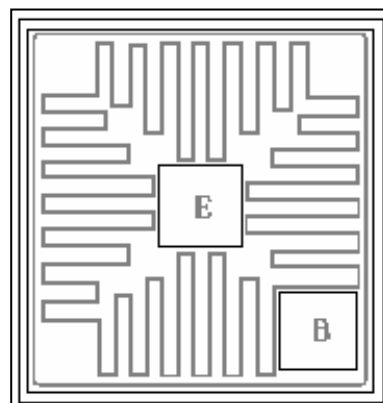
焊位尺寸：B 极 $150 \times 150\mu\text{m}^2$ ；E 极 $153 \times 153\mu\text{m}^2$

电极金属：铝

背面金属：金

典型封装：2SB966，HB966

管芯示意图



极限值（ $T_a=25$ ）（封装形式：TO-92）

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极耗散功率.....	0.75W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-40V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-20V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-7V
I_C ——集电极电流.....	-3A

电参数（ $T_a=25$ ）（封装形式：TO-92）

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			50	nA	$V_{\text{CB}}=-30\text{V}$ ， $I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			50	nA	$V_{\text{EB}}=-5\text{V}$ ， $I_C=0$
V_{CEO}	集电极-发射极电压	-20			V	$I_C=-10\text{mA}$ ， $I_B=0$
V_{EBO}	发射极-基极电压	-6			V	$I_E=-1\text{mA}$ ， $I_C=0$
h_{FE}	直流电流增益	180		800		$V_{\text{CE}}=-2\text{V}$ ， $I_C=-0.5\text{A}$
	直流电流增益	100				$V_{\text{CE}}=-2\text{V}$ ， $I_C=-1\text{A}$
$V_{\text{CE}}(\text{sat})$	集电极—发射极饱和电压			-2	V	$I_C=-3\text{A}$ ， $I_B=-0.1\text{A}$
f_T	特征频率		150		MHz	$V_{\text{CB}}=-6\text{V}$ ， $I_E=-50\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容			50	pF	$V_{\text{CB}}=-20\text{V}$ ， $I_E=0$ ， $f=1\text{MHz}$